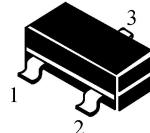


GM9013(销售型號 S9013)

SOT-23

1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR



■FEATURES 特點

NPN Low Frequency Amplifier Transistor

■MAXIMUM RATINGS 最大額定值($T_a=25^\circ\text{C}$)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base voltage 集電極-基極電壓	V_{CBO}	40	Vdc
-Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V_{CEO}	30	Vdc
Emitter-Base voltage 發射極-基極電壓	V_{EBO}	5.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	I_C	500	mAdc
Base-Current 基極電流	I_B	50	mAdc
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P_C	300	mW
Junction Temperature 結溫	T_j	150	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range 儲存溫度	T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

■DEVICE MARKING 打標

GM9013(销售型號 S9013)=J3



桂林斯壯桂微電子有限責任公司
GSME Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GM9013(銷售型號 S9013)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	TYP 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	$V_{CB}=35\text{V}, I_E=0$	—	—	0.1	μA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$	—	—	0.1	μA
Collect-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100 \mu\text{A}$	40	—	—	V
Collect-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1.0\text{mA}$	30	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100 \mu\text{A}$	5	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	$h_{FE}(1)$	$V_{CE}=1\text{V}, I_C=50\text{mA}$	70	—	400	—
	$h_{FE}(2)$	$V_{CE}=6\text{V}, I_C=400\text{mA}$	25	—	—	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$	—	—	0.6	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基極-發射極飽和壓降	$V_{BE(\text{sat})}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$	—	—	1.2	V
Base-Emitter Voltage 基極-發射極電壓	V_{BE}	$V_{CE}=1\text{V}, I_C=100\text{mA}$	—	0.8	1.0	V
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	$V_{CE}=6\text{V}, I_C=20\text{mA}$	150	300	—	MHz
Collector Output Capacitance 輸出電容	C_{ob}	$V_{CB}=6\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	7.0	10	pF

GM9013(销售型号 S9013)

■TYPICAL CHARACTERISTIC CURVE
 典型特性曲线

